

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁶ H03J 3/00	(11) 공개번호 특 1997-0031274
	(43) 공개일자 1997년 06월 26일
(21) 출원번호	특 1995-0040330
(22) 출원일자	1995년 11월 08일
(71) 출원인	대우전자 주식회사 배순훈
(72) 발명자	서울특별시 중구 남대문로 5가 541번지 (우 : 100-095) 심상규
(74) 대리인	경기도 고양시 행신동 소만마을 부영아파트 906-208호 장성구, 김원준

심사청구 : 있음

(54) 듀얼게이트-모스페트(DUAL-GATE MOSFET)를 이용한 튜너(TUNER USING DUAL-GATE MOSFET)

요약

본 발명은 듀얼게이트 모스페트(DUAL-GATE MOSFET)를 이용한 튜너에 관한 것으로, 안테나를 통한 RF신호가 RF앰프를 통해 소정크기로 증폭되어 입력 임피던스가 매칭된 다음, 듀얼게이트 모스페트의 제 1 게이트로 제공되고, LO로부터 발생하는 극초단파의 DC 성분이 C4를 통해 차단되어 듀얼게이트 모스페트의 제 2 게이트로 제공되며, 듀얼게이트 모스페트를 통해 두 신호가 믹싱된 다음 IF 매칭부를 통해 출력 임피던스가 매칭되어 IF 신호가 출력되므로써, RF 신호와 극초단파가 서로 절연되어 듀얼게이트 모스페트로 제공되므로, 두 신호간의 간섭을 방지할 수 있고, 듀얼게이트 모스페트의 동작점의 변화가 작기 때문에 DC 바이어스 변화에 덜 민감하며, 듀얼게이트 모스페트 자체특성상 크로스 모듈레이션과 인터모듈레이션 특성이 우수하여 보다 안정된 IF 신호를 출력할 수 있도록 한 것이다.

대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

듀얼게이트-모스페트(DUAL-GATE MOSFET)를 이용한 튜너(TUNER USING DUAL-GATE MOSFET)

[도면의 간단한 설명]

제2도는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 듀얼게이트 모스페트를 이용한 튜너의 개략적인 블럭구성도.
제3도는 듀얼게이트 모스페트를 설명하기 위한 도면.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

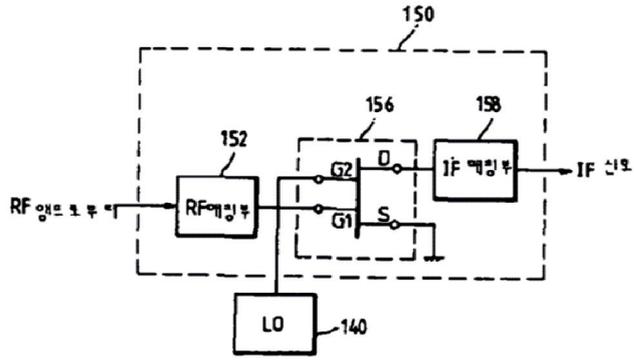
청구항 1

안테나를 통해 포착되는 소망하는 채널의 RF 신호를 소정크기로 증폭하는 RF 증폭수단(110)과, 소정주파수를 갖는 극초단파를 발진하는 발진수단(140)과, 상기 RF 증폭수단(110)에서 소정크기로 증폭된 RF 신호와 상기 발진수단(140)으로부터의 극초단파를 믹싱한 다음 IF 신호를 출력하는 믹스수단(150)으로 구성되는 튜너에 있어서, 상기 믹스수단(150)은, 듀얼게이트 모스페트(156)로 구성된 것을 특징으로 하는 듀얼게이트 모스페트(DUAL-GATE MOSFET)를 이용한 튜너.

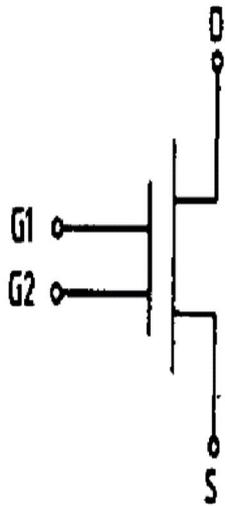
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면2



도면3a



도면3b

